

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Messverfahren für emittierende Bauelemente	4
3.1 Lichtstärke von lichtemittierenden Dioden (I_V)	4
3.2 Strahlstärke von infrarotemittierenden Dioden (I_e)	5
3.3 Spitzenemissionswellenlänge (λ_p), spektrale Bandbreite ($\Delta\lambda$) und Anzahl der Seitenmoden (n_m)	6
3.4 Emissions-Austrittsfläche und Astigmatismus einer Laserdiode ohne Faseranschluss	9
3.5 Halbwertswinkel und Fehlwinkel eines emittierenden Bauelementes	11
4 Messverfahren für lichtempfindliche Bauelemente	13
4.1 Rückwärtsstrom von Photodioden unter Bestrahlung ($I_{R(H)}$ oder $I_{R(e)}$) einschließlich Bauelemente mit oder ohne Faseranschluss und des Kollektorstromes von Phototransistoren unter Bestrahlung ($I_{C(H)}$ oder $I_{C(e)}$)	13
4.2 Dunkelstrom IR von Photodioden und Dunkelströme I_{CEO} , I_{ECO} , I_{EBO} von Phototransistoren	15
4.3 Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $V_{CE(sat)}$ von Phototransistoren	16
5 Messverfahren für Optokoppler	17
5.1 Gleichstrom-Koppelfaktor ($h_{F(ctr)}$)	17
5.2 Koppelkapazität (C_{i0})	18
5.3 Isolationswiderstand zwischen Eingang und Ausgang (r_{i0})	19
5.4 Isolationsprüfung	20
5.5 Teilentladung bei Optokopplern	21
5.6 Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $V_{CE(sat)}$ eines Optokopplers	25
5.7 Schaltzeiten t_{on} , t_{off} von Optokopplern	27
5.8 Größter Sperrstrom (I_{DRM})	28
5.9 Größte Durchlassspannung (V_{TM})	30
5.10 Sperrgleichstrom (I_{BD})	32
5.11 Durchlassgleichspannung (V_T)	33
5.12 Haltestrom (I_H)	33
5.13 Kritische Sperrspannungssteilheit (dV/dt)	34
5.14 Triggereingangsstrom (I_{FT})	37
5.15 Prüfverfahren für die elektrische Bemessung von Fototriac-Kopplern	38
Anhang A (informativ) Querverweise	40
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	42